

350.7/4



SEGUNDO CERTIFICADO DE ADICIÓN

por VEINTE años

en España, a favor de la firma FAGOR ELECTROTEC-  
NICA, S.C.I., establecida en MONDRAGÓN (Guipuzcoa)  
Barrio de San Andres, cuya adición tiene por obje-  
to:

MEJORAS EN LA PATENTE DE INVENCION Nº 328.019, LA  
CUAL SE REFIERE A "PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN -  
DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES".

.-----oOo-----.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Certificado de Adición se -  
relaciona con unos perfeccionamientos introducidos  
en el proceso de fabricación de dispositivos semi-  
conductores y más en particular aporta ciertas me-  
joras en el procedimiento de fabricación reivindi-  
cado en la Patente de Invención principal número -  
328.019 y en su primer Certificado de Adición núm.,  
330.248, que coadyuvan ventajosamente a la conse-  
cución de los fines provistos.

5.-

10.-

En dicha patente principal y en su pri-  
mera adición se ha provisto que la preparación de  
la placa base se realice por ahorro de arena o me-  
diante un sistema galvánico.



Una de las mejoras aportadas por la presente adición consiste en la preparación de la placa base mediante un decapado y una corrosión por medio de un ácido de un halógeno.

5.-

El objeto de dicha corrosión es aumentar la superficie útil o de contacto de la placa base.

10.-

Después se somete a la placa base a un baño de ácido nítrico y ácido fluorhídrico para eliminar los restos de impurezas motivados por la corrosión.

Otra de las mejoras introducidas es la deposición del níquel en lugar de bismuto.

15.-

De esta forma se consigue un proceso más correcto de la placa base, siendo la resistencia tanto en el sentido directo como en el inverso inferior.

20.-

Al ser la resistencia en sentido directo pequeña y en sentido inverso grande y al disminuir esta resistencia en los dos sentidos, se tiene un porcentaje de disminución bastante notable en sentido directo, siendo apenas notable esta disminución en sentido inverso.

25.-

Por lo tanto se tiende a un mejoramiento de la calidad de la placa al mejorar la corriente directa.

30.-

A continuación se opera igual que en el 1er. Certificado de Adición.

Descrita convenientemente la naturaleza de este segundo Certificado de Adición, como

5.- asimismo la forma de poderlo llevar a la práctica para convertirlo en una realidad industrializable, se hace constar que en el mismo serán susceptibles de introducir todas aquellas modificaciones de detalle que las circunstancias y la práctica pudieran aconsejar, siempre y cuando que con las variantes que se introduzcan no se cambie, al tere o modifique la esencialidad del objeto descrito.

10.-

NOTA

Se declara como de propiedad y novedad para todo el territorio español, el contenido de las siguientes:

REIVINDICACIONES

15.-

1ª Perfeccionamientos introducidos en la Patente de Invención nº 328.019, la cual se refiere a "PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES", de acuerdo con los cuales, la placa base es sometida a un decapado y una corrosión a base de un ácido de un halógeno para aumentar la superficie útil de contacto.

20.-

2ª Perfeccionamientos introducidos en la Patente de Invención nº 328.019, la cual se refiere a "PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES", de acuerdo con los cuales la placa base se somete después de la corrosión a un baño de ácido nítrico y ácido fluorhídrico.

25.-

3ª Perfeccionamientos introducidos en la Patente de Invención nº 328.019, la cual se refiere a "PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES", de acuerdo con los cua-

30.-



les, sobre la placa base después del baño citado, se deposita níquel para disminuir la resistencia en los dos sentidos.

5.-

4ª Perfeccionamientos introducidos en la Patente de Invención nº 328.019, la cual se refiere a "PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES".

10.-

Todo ello, conforme se describe y reivindica en la presente memoria que consta de CUATRO Hojas, escritas a máquina.

Madrid, 20 de Febrero de 1.968

~~S. GONZALEZ LACAS  
P. P.~~